

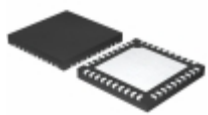

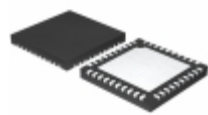




	<h2>SI3451DV-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3451DV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.8A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3451DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23584 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3451DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.8A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	23584 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2.8A (Tc) 1.25W (Ta), 2.1W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 2.1W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 2.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.1nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3451DV-T1-E3TR

SI3451DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3451DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3451DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3451DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3448BDV</b> VISHAY VISHAY sot163</p>	 <p><b>SI3452-B01-IM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC POE CONTROLLER MIDSPAN 40QFN</p>	 <p><b>SI3451DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3452-B01-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC POE CONTROLLER MIDSPAN 40QFN</p>
 <p><b>SI3448DV-T1-E3</b> VISHAY SI3448DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3450-GM</b> SILICON SILICON QFN40</p>	 <p><b>SI3447DV-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SI3447DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3448DV</b> VISHAY SI3448DV VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

SI3446DV-T1	SI3446DV-T1-E3	SI3446DV-T1-GE3	SI3446DV-TI-E3	SI3447BDS
SI3447BDV	SI3447BDV-T1	SI3447BDV-T1-E3	SI3447BDV-T1-GE3	SI3447BDV-T1-GE3
SI3447BDV-T1-GE3	SI3447BDV-TI-GE3	SI3447CDV-T1	SI3447CDV-T1-E3	SI3447CDV-T1-E3
SI3447CDV-T1-GE3	SI3447CDV-T1-GE3	SI3447DV	SI3447DV-NL	SI3447DV-T1
SI3447DV-T1-E3	SI3447DV-T1-GE3	SI3448DV	SI3448DV-T1-E3	SI3451DV-T1-E3
SI3451DV-T1-GE3	SI3451DV-T1-GE3	SI3452DV-T1-E3	SI3453DV-T1-GE3	SI3453DV-T1-GE3
SI3453DV-T5-GE3	SI3454ADV-T1	SI3454ADV-T1-E3	SI3454ADV-T1-E3	SI3454ADV-T1-GE3
SI3454ADV-T1-GE3	SI3454CDV-T1-GE3	SI3454CDV-T1-GE3	SI3454DV-NL	SI3454DV-T1
SI3454DV-T1-E3	SI3455ADV-T1-E3	SI3455ADV-T1-E3	SI3455ADV-T1-GE3	SI3455ADV-T1-GE3
SI3455DV-NL	SI3455DV-T1-E3	SI3455DV-T1-GE3	SI3456-C02-GU	SI3456-E04-GU

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited